半导体物理

课后作业03 参考解答

助教: 王晓荣072052058@fudan.edu.cn

杨金东072052053@fudan. edu. cn

1、设点阵常数为a的一维晶体,导带极小值附近能量Ec(k)和价带极大值附近能量Ev(k)分别为:

$$E_c(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{3m_0} + \frac{\hbar^2 (k - k_1)^2}{m_0} \qquad E_v(k) = \frac{\hbar^2 k_1^2}{6m_0} - \frac{3\hbar^2 k^2}{m_0}$$

其中, m_0 为电子惯性质量, $k_1 = \pi / a$,a=0.314nm,求解:

(1) 禁带宽度

解:

$$E_c(k)_{\min} = \frac{\hbar^2 k_1^2}{4m_0} \qquad (k = \frac{3}{4}k_1)$$

$$E_{\nu}(k)_{\text{max}} = \frac{\hbar^2 k_1^2}{6m_0}$$
 $(k=0)$

则禁带宽度:

$$E_g = E_c(k)_{\min} - E_v(k)_{\max} = \frac{1}{12} \frac{\hbar^2 k_1^2}{m_0}$$

(2) 导带底电子有效质量

$$E(k) - E(\frac{3}{4}k_1) = \frac{1}{2} \frac{d^2 E}{dk^2} \Big|_{k = \frac{3}{4}k_1} \cdot \left(k - \frac{3}{4}k_1\right)^2$$

$$E(k) = E(\frac{3}{4}k_1) + \frac{\hbar^2 \left(k - \frac{3}{4}k_1\right)^2}{2m_n^*}$$

$$\left. m_n^* = \hbar^2 / \frac{d^2 E}{dk^2} \right|_{k = \frac{3}{4}k_1} = \frac{3}{8} m_0$$

(3) 价带顶电子有效质量

$$E(0) - E(k) = \frac{1}{2} \frac{d^{2}E}{dk^{2}} \Big|_{k=0} \cdot k^{2}$$

$$E(k) = E(0) - \frac{\hbar^{2}k^{2}}{2m_{n}^{*}}$$

$$m_n^* = \hbar^2 / \left(\frac{d^2 E}{dk^2}\right|_{k=0}) = -\frac{1}{6}m_0$$

(4) 价带顶电子跃迁到导带底时电子准动量的变化

准动量
$$P=\hbar k$$

$$P_c = \hbar k \Big|_{k = \frac{3}{4}k_1} \qquad \qquad P_v = 0 \Big|_{k=0}$$

$$\Delta P = P_c - P_v = \frac{3}{4}\hbar k_1$$

2、点阵常数为0. 25nm的一维晶体,当外加10²V/m,10⁷V/m的电场时,试分别计算电子自能带底运动到能带顶所需的时间。

解:

$$\frac{dk}{dt} = \frac{-q\left|\vec{E}\right|}{\hbar}$$

说明所有电子都以同一速度在波矢空间内漂移,则:能带底部到顶部对应的k变化量为半个布里渊区宽度

$$t = \frac{\pi / a}{q |E| / \hbar}$$

$$t_1 = 8.82 \times 10^{-8} s$$

$$t_2 = 8.82 \times 10^{-13} s$$